



## 科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	一种SiC肖特基二极管及其制作方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201310580966.2
申请日期:	2013-11-18
专利号:	201310580966.2
第一发明人:	刘新宇;许恒宇;汤益丹;蒋浩杰;赵玉印;申华军;白云;杨谦
实施情况:	授权
专利证书号:	201310580966.2
其它备注:	高频高压中心

